



现在位置：首页 > 新闻动态 > 科研动态

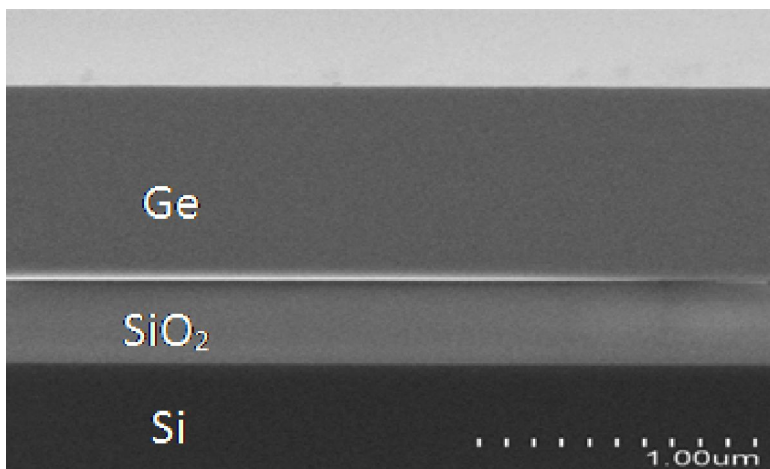
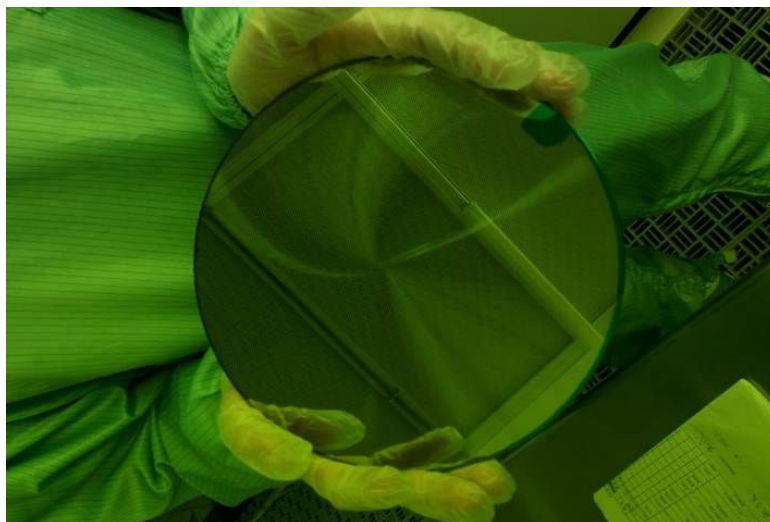
新闻动态

- ▶ 图片新闻
- ▶ 头条新闻
- ▶ 综合新闻
- ▶ 学术活动
- ▶ 科研动态
- ▶ 通知公告
- ▶ 业内信息
- ▶ 合作交流
- ▶ 科研项目资金管理

微电子所在8寸平台上成功制造绝缘体上张应变锗 (TSGOI) 晶圆

2018-08-30 | 编辑：先导中心 赵雪薇 崔冬萌 | 【大 中 小】 【打印】 【关闭】

近日，中国科学院微电子研究所研究员Henry Radamson和副研究员王桂磊在先导中心8寸平台上成功制造绝缘体上张应变锗 (TSGOI) 晶圆。该项技术突破，实现了工艺过程中对Ge的诱导应变微调，使Ge的带隙改变为0.7eV。以此类Ge衬底制备的PMOS器件实现了506cm<sup>2</sup>V<sup>-1</sup>s<sup>-1</sup>的高空穴迁移率。这一成果为微电子学和光子学的单片集成提供了新的路径和解决方案。



TSGOI晶圆的俯视图及其横截面

附件下载：

相关新闻：

[SOI-1000](#)

[中国科学院微电子研究所与中芯国际签订MEMS研发代工平台合作协议](#)

[微电子概述](#)



中国科学院微电子研究所版权所有 邮编：100029

单位地址：北京市朝阳区北土城西路3号，电子邮件：webadmin@ime.ac.cn

京公网安备110402500036号

